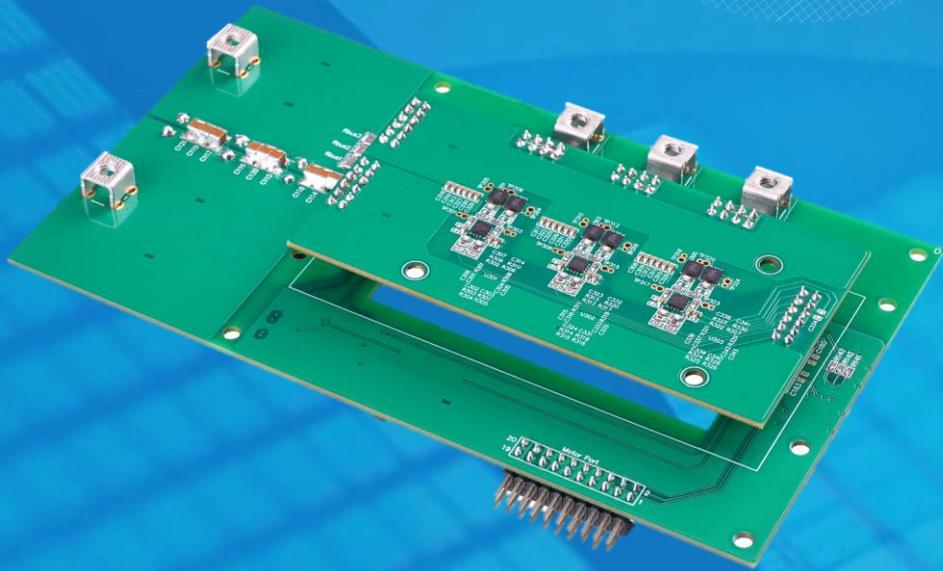


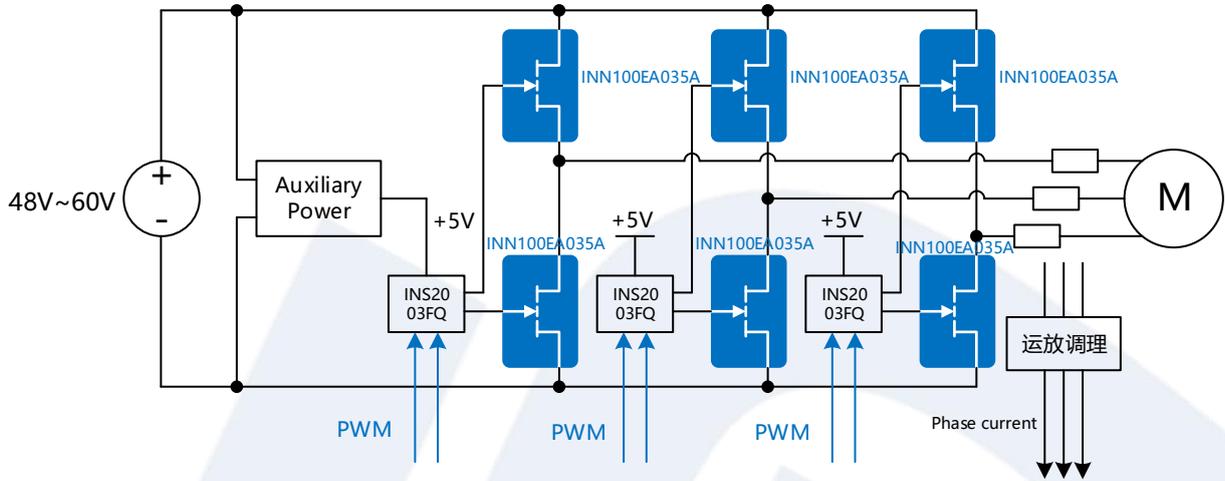
INN100EA035A

Demo Manual
48V 25A Motor Drive
Featuring INN100EA035A



48V 25A 电机驱动

● 三相电机驱动方案

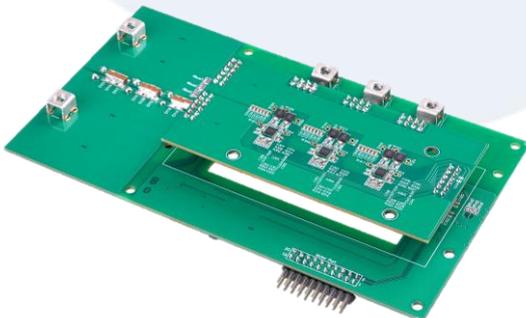


INNMD48V25A1 功率管采用 INN100EA035A，驱动采用 INS2003FQ，输入 $48V_{dc}-60V_{dc}$ ，持续输出相电流峰值 25A，能够满足 1kW 电机驱动应用需求。INNMD48V25A1 包含一块母版和一块功率子板，两者可以组装在一起测试 INN100EA035A 在电机驱动应用中的性能。

● 重点器件

- INN100EA035A*6
- INS2003FQ*3

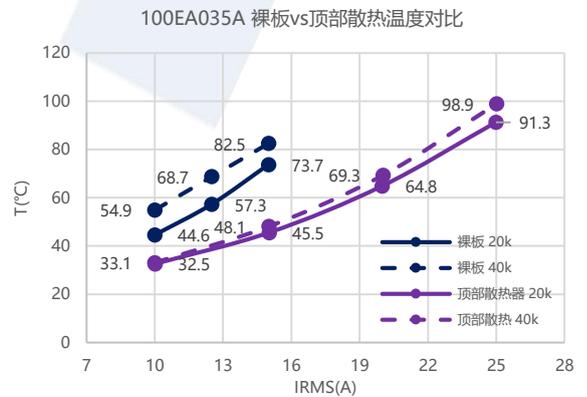
● 实物图



● 应用场景

- 机器人
- 无人机

● 测试数据



目 录

1. 概述	1
1.1. 引言	1
1.2. 应用场景.....	1
2. 关键参数.....	2
3. Demo方案.....	3
3.1. 系统	3
3.2. GaN的应用优势.....	3
3.3. 重点器件介绍	4
3.3.1. INN100EA035A	4
3.3.2. INS2003FQ.....	5
4. 硬件方案.....	6
4.1. 硬件介绍.....	6
4.2. 设计要点.....	7
4.2.1. GaN Layout设计	7
5. Demo测试结果	8
5.1. 整机测试结果	8
5.2. 效率测试结果	8
5.3. 温度测试结果	9
附录 Appendix	11
附录 A. 测试指导 Testing Guidance.....	11
附录 B. 原理图.....	13
附录 C. PCB Layout.....	15
附录 D. BOM.....	18
历史版本.....	21

1. 概述

1.1. 引言

INNDMD48V25A1 功率管采用 INN100EA035A，驱动采用 INS2003FQ，输入 $48V_{dc}$ - $60V_{dc}$ ，持续输出相电流峰值 25A，能够满足 1kW 电机驱动应用需求。INNDMD48V25A1 包含一块母版和一块功率子板，两者可以组装在一起测试 INN100EA035A 在电机驱动应用中的性能。

1.2. 应用场景

- 机器人
- 无人机

2. 关键参数

表 1 关键电气参数表(Ta = 25 °C)

Symbol	Parameter	Min	Nom	Max	Unit
V _{in}	输入电压	24	48	60	V _{dc}
F _s	开关频率	0	20	100	kHz
T _d	死区时间	20	100		ns
I _{OUT}	持续输出相电流		25		A
P _{OUT}	持续输出功率		1000		W

3. Demo方案

3.1. 系统

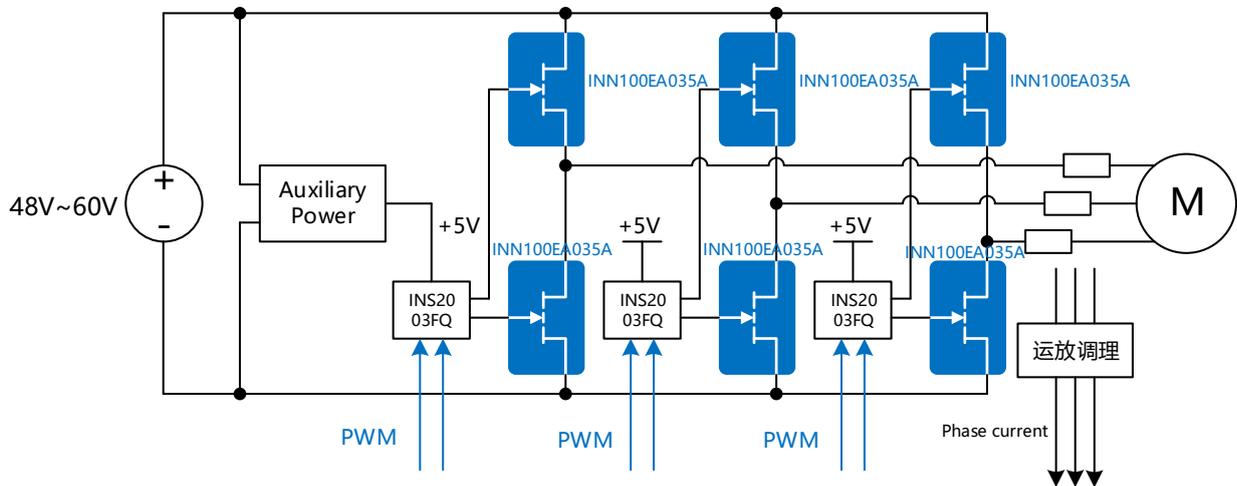


图 1 INNDMD48V25A1系统框图

INNDMD48V25A1包含三相功率半桥，每一相使用一颗100V半桥驱动INS2003FQ及两颗100V GaN器件INN100EA035A。PWM信号由控制器通过接口输入，相电流经过采样及调理电路后输入控制器，辅助电源为以上各部分供电。

3.2. GaN的应用优势

GaN在电机驱动应用中相比于Si有以下几点优势：

- 栅极电荷 Q_g

同样内阻的器件，GaN栅极电荷相较于Si减小5倍左右，更小的栅极电荷意味着更快的开通关断速度及更小的驱动及开关损耗。与此同时，高开关速度能够有效降低死区时间，在电机驱动系统中，这能够降低THD，转矩脉动和电机本体的机械噪声。

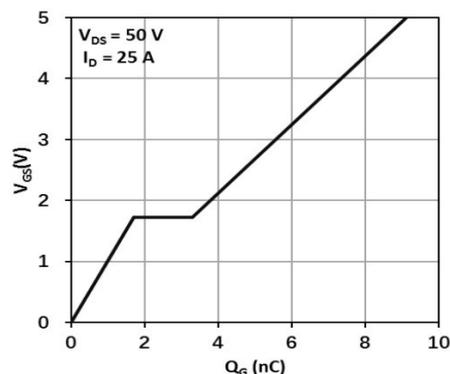


图 2 GaN典型栅极电荷

■ 反向恢复电荷 Q_{rr}

Si MOS内部寄生二极管在关断时存在较大的反向恢复电荷，这会导致开关过程引入额外的损耗及电压尖峰。GaN开关过程没有少数载流子的复合，因此没有反向恢复问题，这使得GaN非常适合电机驱动等硬开关应用。

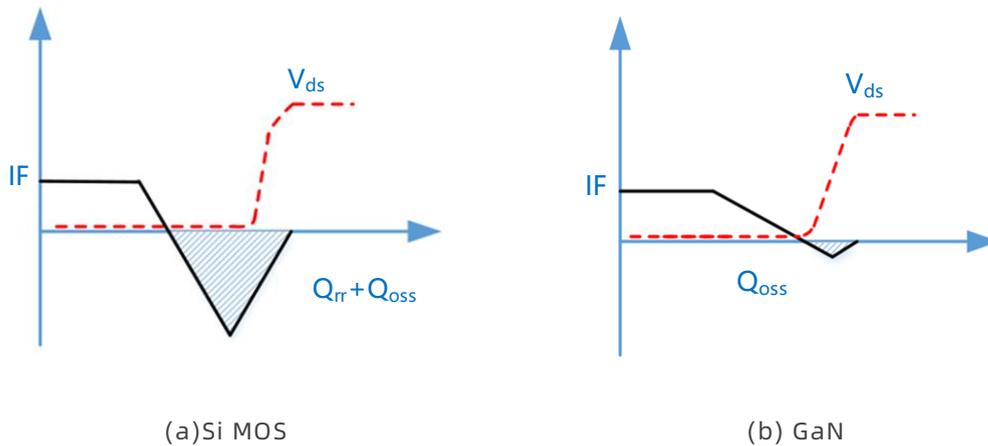


图 3 器件关断波形

3.3. 重点器件介绍

3.3.1. INN100EA035A

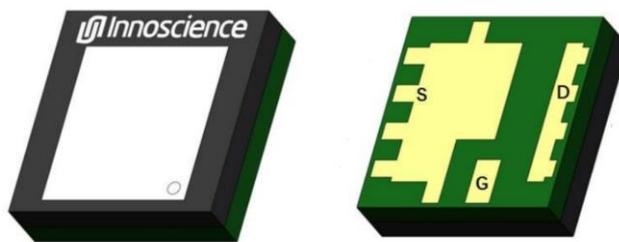


图 4 分立GaN器件100EA035A

INN100EA035A是英诺赛科的一款采用En-LGA 3mm x 3mm封装的100V 3.5mΩ硅氮化镓增强型功率晶体管。INN100EA035A能够帮助电机驱动系统实现更紧凑的PCB设计及更优秀的温度表现。与相似内阻的Si MOS相比，INN100EA035A具有更小的电容参数，且没有反向恢复，详细对比数据如表 2所示。

表 2 GaN vs Si电气性能对比

Parameter	INN100EA035A	xxx034xxxxxx
$R_{ds(on),max}(m\Omega)$	3.5	3.4
$Q_g(nC)$	7.6(0.21)	37
$Q_{oss}(nC)$	42(x0.46)	91

$Q_{rr}(nC)$	0(x0)	42
$FOM(R_{on} * Q_g)$	31.9(x0.25)	125.8
$FOM(R_{on} * Q_{oss})$	176.4(x0.57)	309.4
Package	En-FCLGA	QFN

3.3.2. INS2003FQ

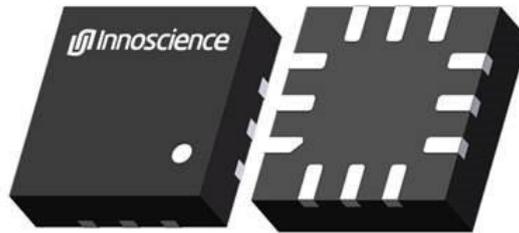


图 5 100V GaN驱动 INS2003FQ

INS2003FQ是英诺赛科推出的一款100V GaN专用半桥驱动器，相较于传统Si MOS驱动器，其针对GaN驱动特性进行了优化以适应GaN器件的需求。INS2003FQ使用智能自举开关对上管BST电容充电，这使得死区期间内BST电容不会出现过充电进而导致器件过压。INS2003FQ输入具有互锁功能，即使PWM输入死区时间设置为零，器件仍不会出现直通。INS2003FQ高低边输入具有独立的通道，这使得其具有极高的自由度。INS2003FQ驱动输出上拉和下拉具有独立引脚，这使得其开关速度能够分别调节，配合其本身较强的驱动能力，使得其非常适合大功率高开关频率应用场景。

4. 硬件方案

4.1. 硬件介绍

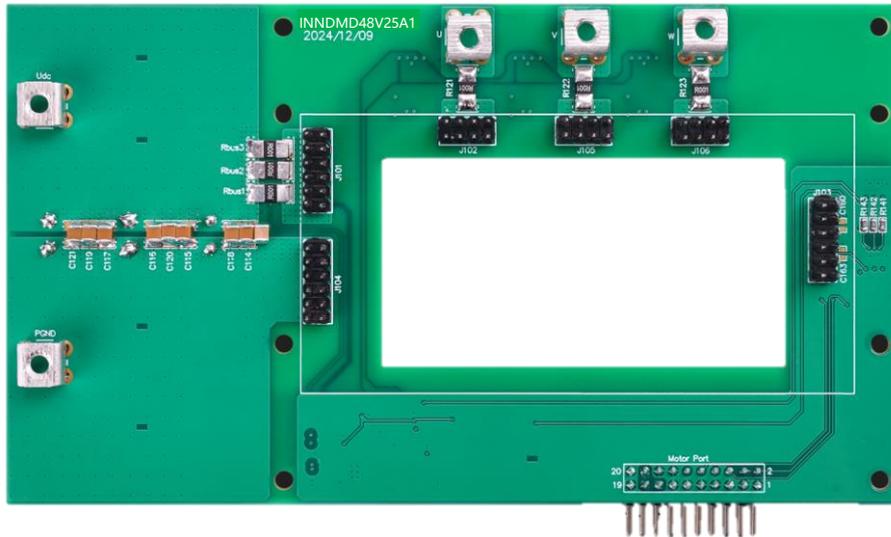


图 6 母板Top视图

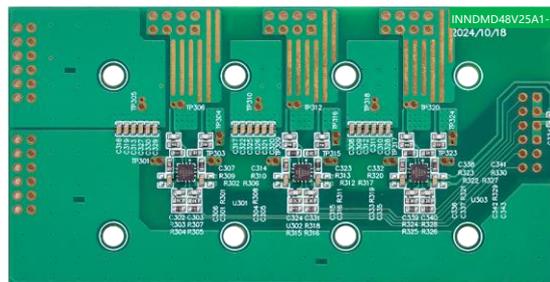


图 7 功率子板Top视图

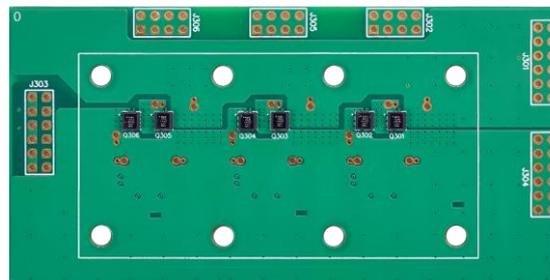


图 8 功率子板Bottom视图

INNDMD48V25A1母板与功率子板的图片如图6和图7所示，其具有以下功能电路：

- 1) 三相半桥：功率子板包含三相半桥，每一相由一颗半桥驱动INS2003FQ和两颗GaN器件INN100EA035A组成。
- 2) 电流采样：母板包含采样电阻及采样调理电路，采样三相相电流信号。
- 3) 辅源：母版包含高压辅源，可直接为驱动及采样电路供电。

4.2. 设计要点

GaN器件的栅极电容和米勒电容都比Si小，因此，GaN器件能够实现较快的开关速度。为避免大 di/dt 和 dv/dt 产生大电压电流应力，需要优化栅极回路及功率回路的Layout以减小寄生参数的影响。

4.2.1. GaN Layout设计

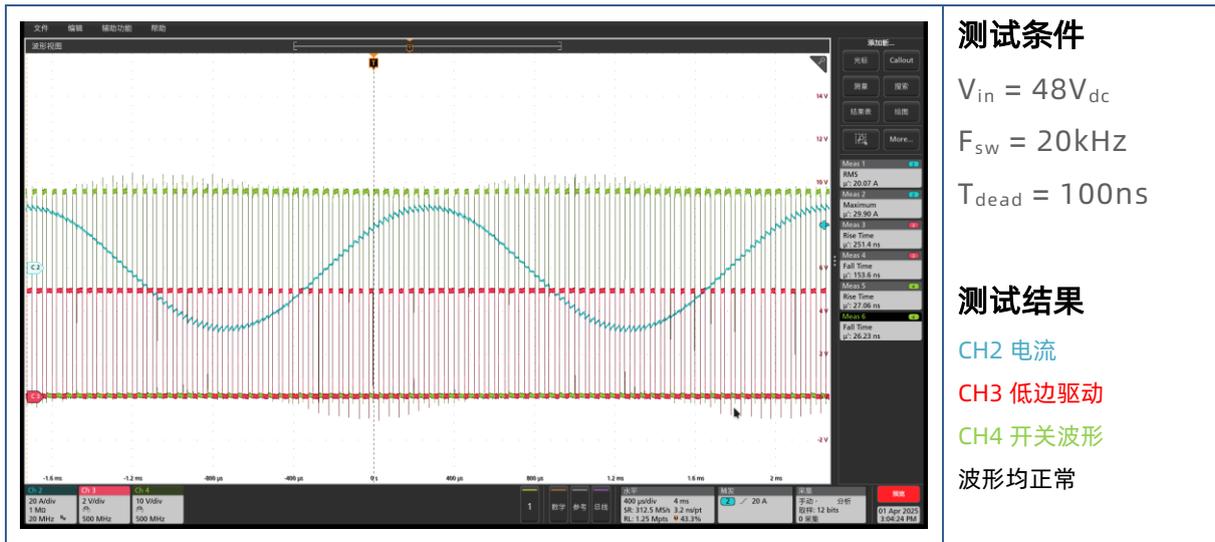
共源电感CSI、功率回路、驱动回路对GaN的工作性能都有影响，如何减小这三部分的寄生电感，是GaN Layout设计的重要关注点。在GaN的Layout设计中，我们应尽量遵循以下几个设计原则：

- 1) 共源电感CSI越小越好。
- 2) 功率回路越小越好。在大容量电容距离GaN器件的换流回路相对远了的情况下，就近增加高频无感贴片电容以减小功率换流回路。
- 3) 驱动回路越小越好，驱动电路尽量靠近GaN器件。
- 4) 驱动回路和功率回路尽量采用磁场自消除的布局和走线方式以减小回路电感。
- 5) 驱动回路和功率回路分开，避免驱动回路与功率回路的电路和空间耦合，以避免功率回路对驱动回路的干扰。

5. Demo测试结果

5.1. 整机测试结果

使用电抗台架测试GaN效率及温升表现，输入电压48V，开关频率20kHz，死区时间100ns，整机测试波形如下图所示，蓝色电流呈正弦波，红色低边驱动及绿色开关波形均正常。



5.2. 效率测试结果

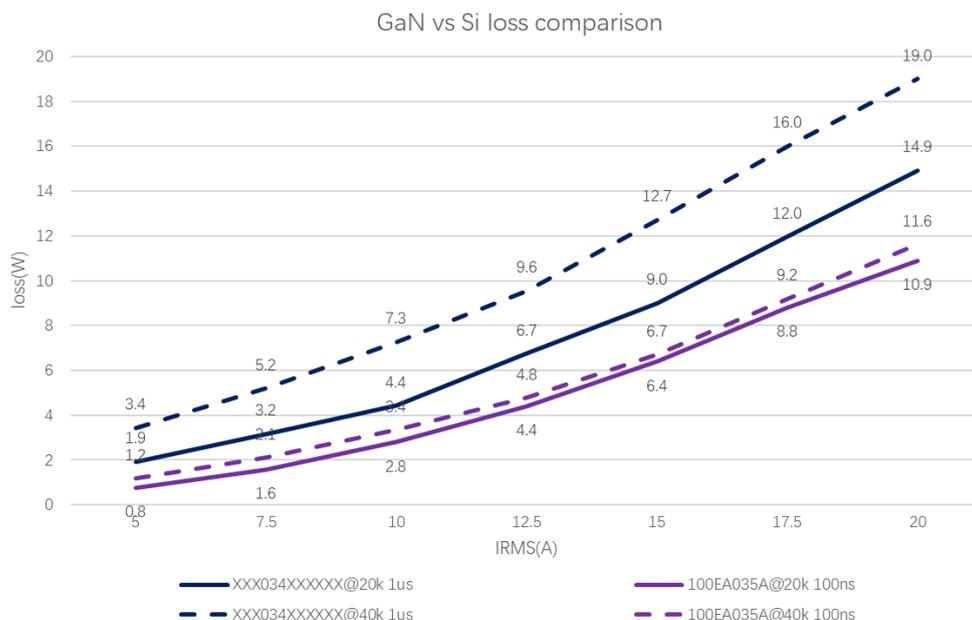


图 9 损耗对比曲线

INN100EA035A和类似参数Si MOS损耗对比数据如图 9所示，当开关频率设置为

20kHz时，相电流有效值为5A时，GaN的系统损耗从Si的1.9W降低到0.8W，降低了58%；相电流有效值为20A时，GaN的系统损耗从Si的14.9W降低到10.9W，降低了27%。当开关频率设置为40kHz时，相电流有效值为20A时，GaN的系统损耗从Si的19W降低到11.6W，降低了39%。开关频率从20kHz提高到40kHz，GaN的系统损耗增量从Si的4.1W降低到0.7W，降低了17%。

5.3. 温度测试结果

使用热成像仪测试无散热器时INNDMD48V25A1器件壳温，如图 10所示电流有效值为15A时，三相半桥温度基本均匀，中间相由于热量集中温度最高，最高温度约为73°C。

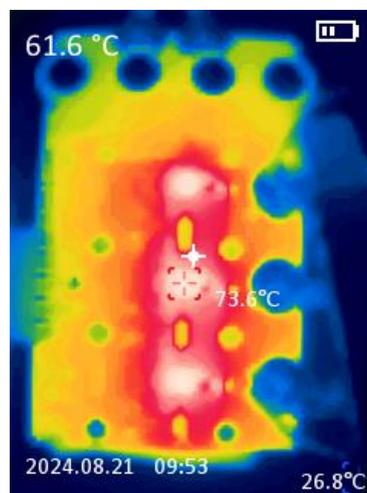


图 10 整机温度测试图片

自然冷却条件下INNDMD48V25A1不带散热器温度测试结果如图 11所示，相较于Si，GaN器件的温度在20kHz和40kHz下分别降低了14°C和30°C。

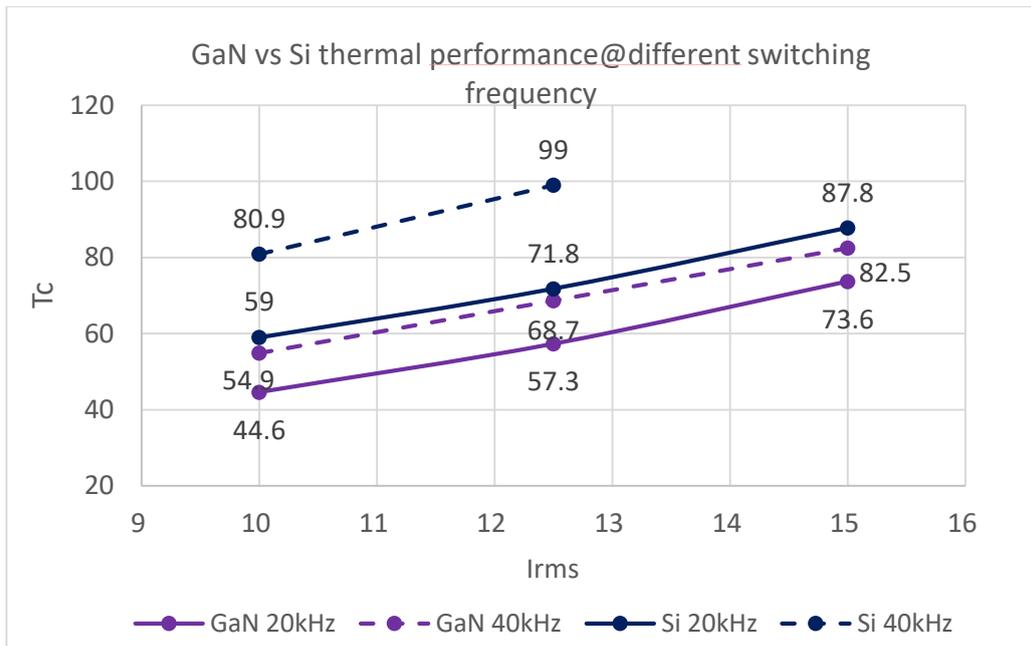


图 11 无散热器条件下温度对比

带散热器温度测试结果如图 12所示，散热器尺寸为70mmx35mmx25mm，散热器通过导热系数为4W/m°C的TIM连接到INN100EA035A顶部。测试结果显示，相较于Si竞品，GaN相同电流负载情况下器件温度降低了28°C，最大输出电流有效值扩展了7.5A。

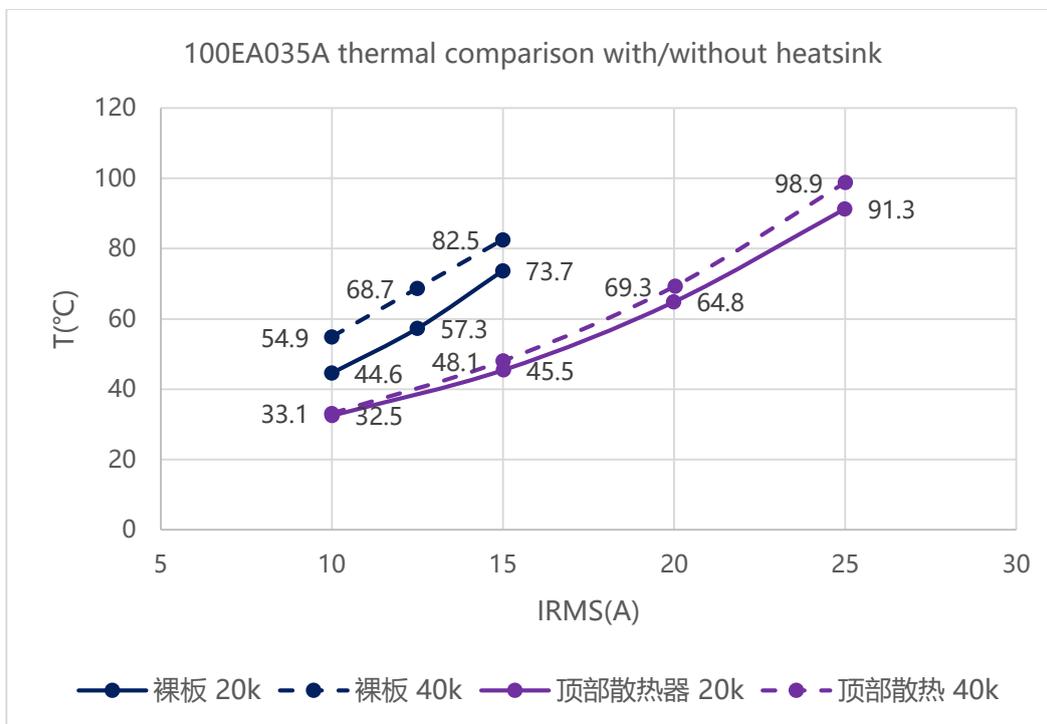


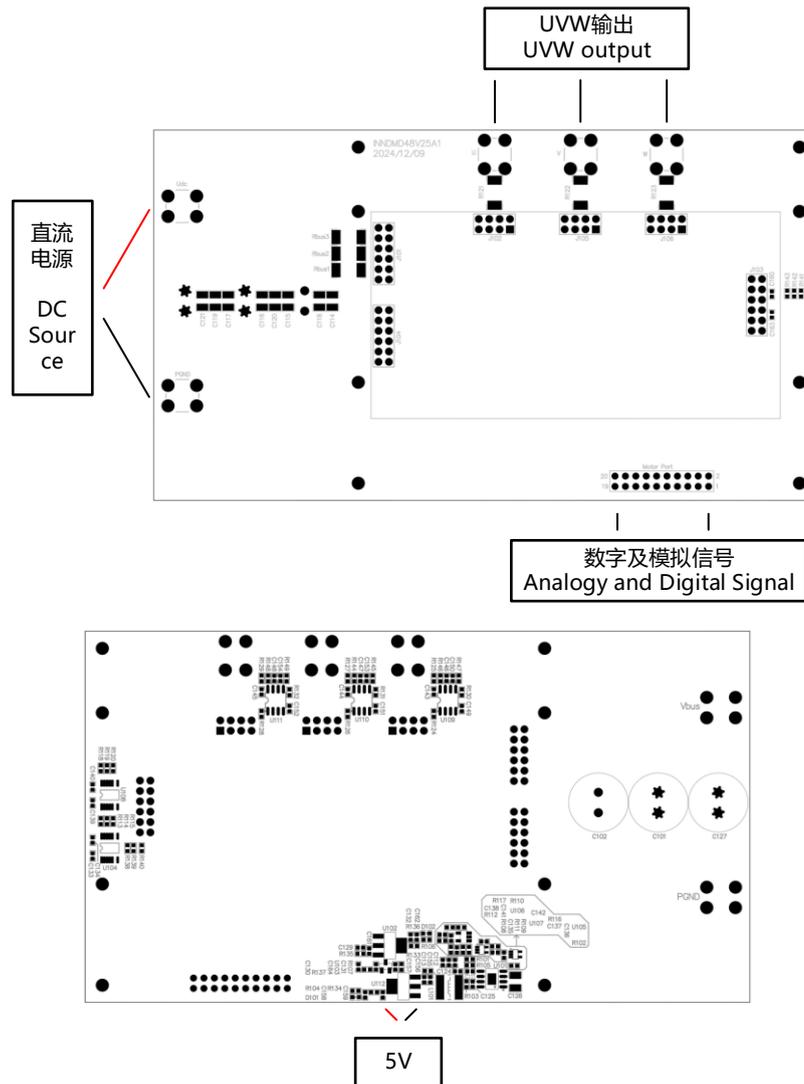
图 12 带散热器条件下温度对比

附录Appendix

附录 A. 测试指导 Testing Guidance

1、 测试点位置和接线示意图

Test point location and wiring diagram



附录图 1 系统接线图

附录表 1 数字及模拟接口定义

Pin	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Description	PWMHU	PWMLU	PWMHV	PWMLV	PWMHW	PWMLW	GND	GND	IV	GND
Pin	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
Description	ENC_H1	ENC_H2	ENC_H3	GND	GND	GND	GND	IU	IW	GND
PWMXX	PWM signal									
ENC_HX	level shift for encoder									
IX	current sample signal									

2、 上/下电顺序

Power on/off sequence

1. 确保所有电源处于下电状态。

Ensure all the power supplies are off.

2. 将电源连接至Demo板Vin及GND端口，连接5V辅源供电，如附录图 1所示（注意极性）

Connect the DC voltage source to terminal Vin and common ground terminal GND, connect the 5V auxiliary power supply, as shown in Appendix Figure1(note polarity).

3. 将电机或电抗负载连接至Demo板UVW端口，如附录图 1所示。

Connect the Motor or RL load to UVW output terminal, as shown in Figure.

4. 将控制器PWM信号，模拟信号及GND连接至Demo板对应端口，如附录表 1所示。

Connect the controller to demo board including PWM signals, analog signals and GND.

5. 检查控制器输出及反馈信号波形，确保各波形与理论一致。

Turn on the controller and output the PWM signal with the required duty ratio and frequency, ensure PWM input of each ISG3204 is same as controller output.

6. 缓慢增加电源输出电压，并确保电源输出电压不超过60V。

Make sure the initial input supply voltage is 0 V, turn on the power and slowly increase the voltage to the desired value (do not exceed the absolute maximum voltage).

7. 测试各关键节点波形及器件性能。

Ensure three-phase SW waveforms are correct before controlling motor as wanted.

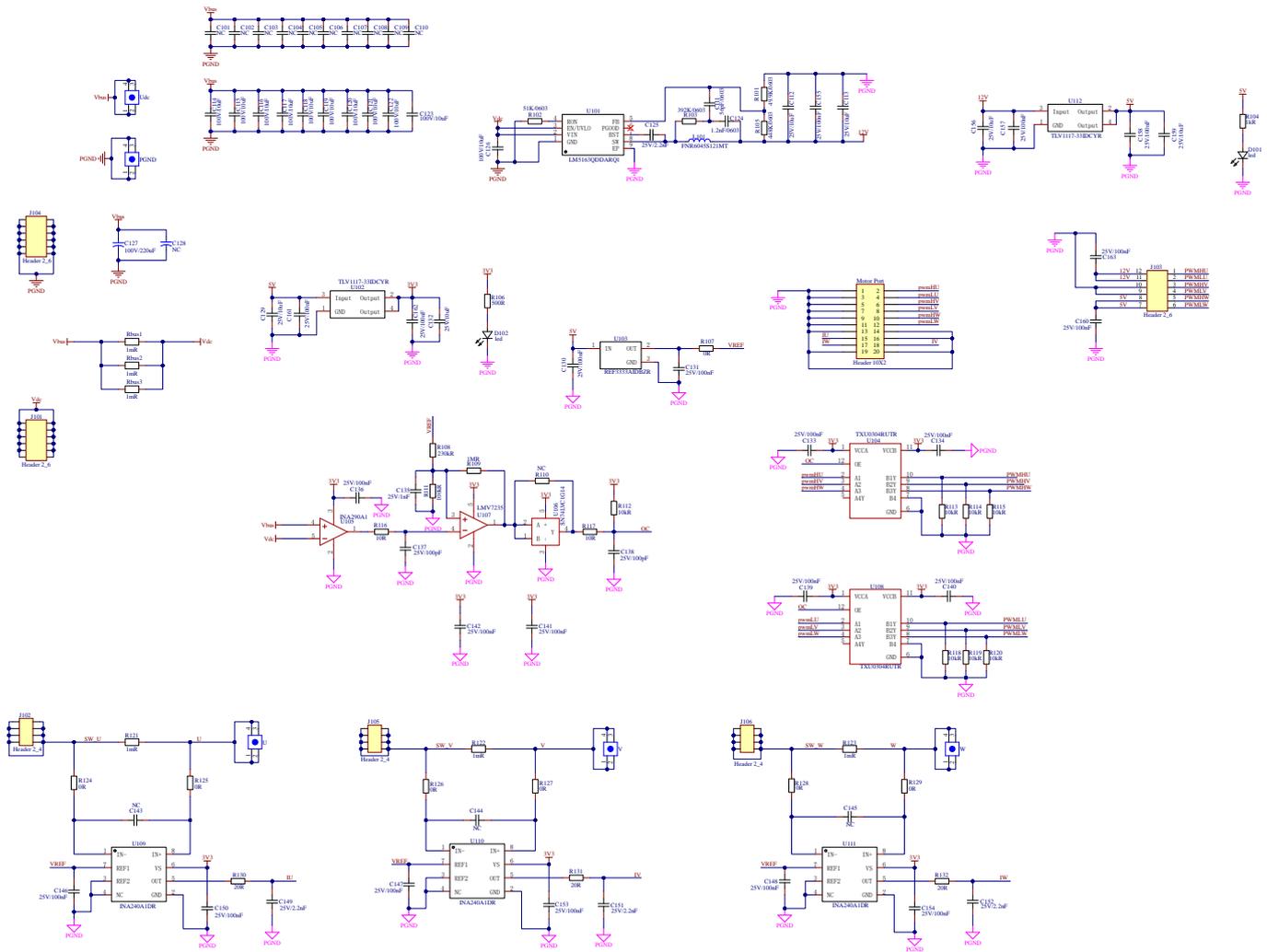
8. 关闭电源。

Turn off the DC voltage source if all measurement is done.

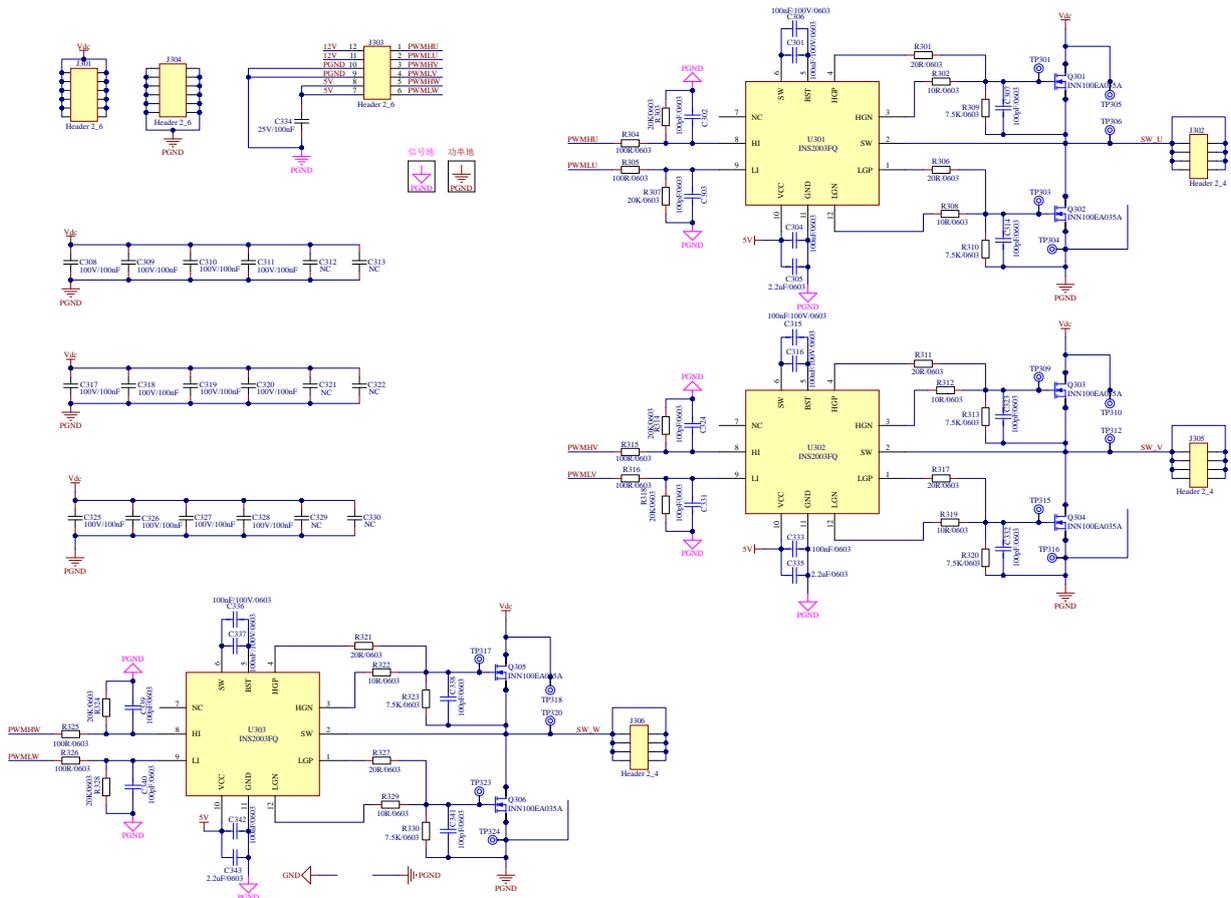
9. 关闭控制器。

Turn off the controller.

附录 B. 原理图

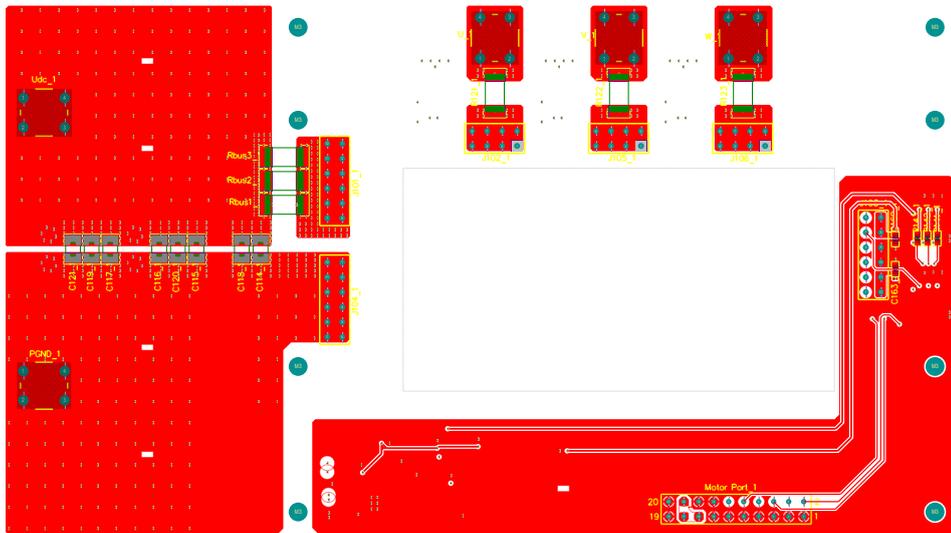


附录图 2 INNDMD48V25A1 电路原理图 (母板)

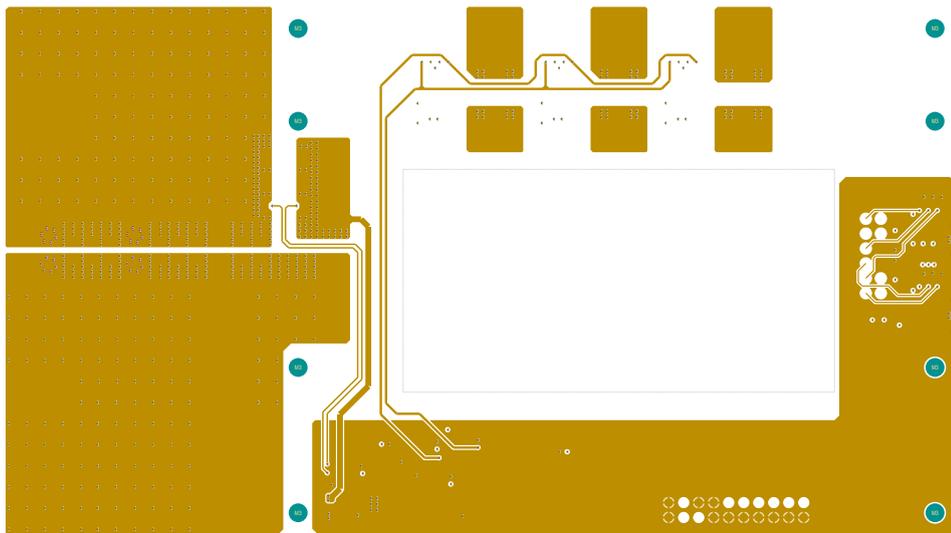


附图3 INNDMD48V25A1电路原理图 (子板)

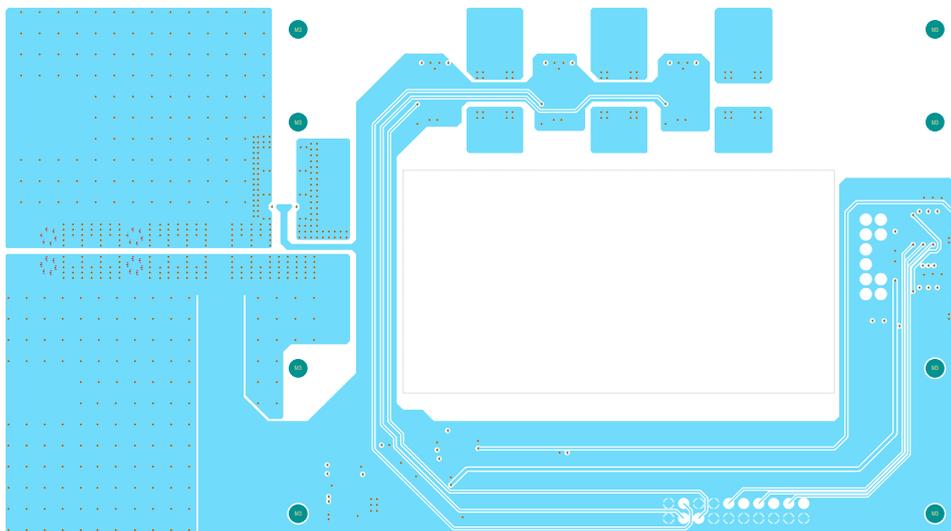
附录 C. PCB Layout

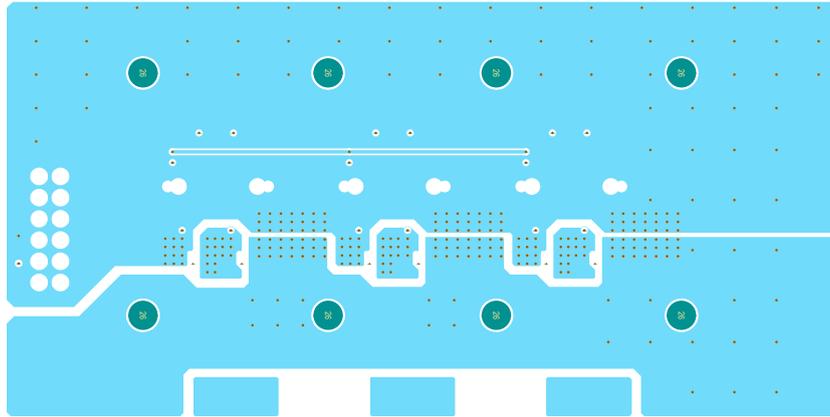


附录图 4 母板Top层

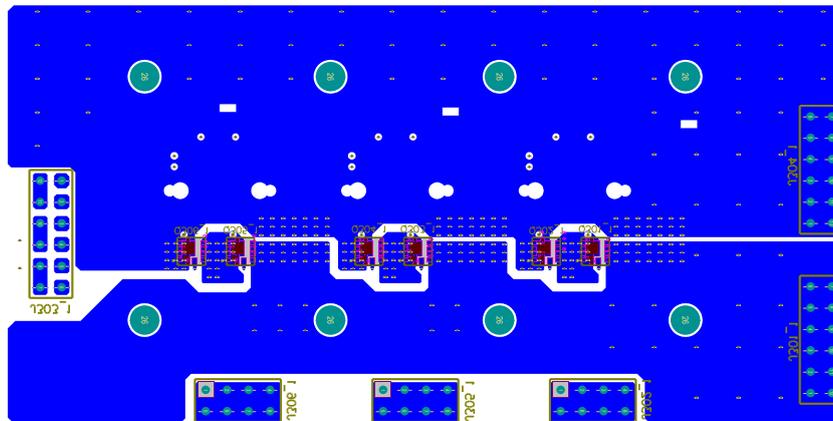


附录图 5 母板Top层





附录图 10 子板Mid2层



附录图 11 子板Bottom层

附录 D. BOM

Part Number	Manufacture	Description	Designator	Footprint	Quantity
Motherboard					
C0603X560K3HAC7867	KEMET	CAP, 56p/25V, ±10%, X8R	C111	C0603	1
GRM188R61E106KA73 D	muRate	CAP, 10u/25V, ±5%, COG	C112, C113, C129, C132, C156, C159	C0603	6
GRM32EC72A106KE05 L	muRate	CAP, 10u/100V, ±10%, X7S	C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C126	C1210	11
CC0603JRNPO8BN122	YAGEO	CAP, 1.2n/25V, ±5%, NPO	C124	C0603	1
CC0603KRX7R8BB222	YAGEO	CAP, 2.2n/25V, ±10%, X7R	C125, C149, C151, C152	C0603	4
ERJ1KM221W200T	AISHI	CAP, 220u/100V E-cap	C127, C128	C2-12r5-5r0	1
CC0603KRX7R8BB104	YAGEO	CAP, 100n/25V, ±10%, X7R	C130, C131, C133, C134, C136, C139, C140, C141, C142, C146, C147, C148, C150, C153, C154, C155, C157, C158, C160, C161, C162, C163	C0603	22
CC0603KRX7R8BB102	YAGEO	CAP, 1n/25V, ±10%, X7R	C135	C0603	1
CC0603JRNPO8BN101	YAGEO	CAP, 100p/25V, ±5%, NPO	C137, C138	C0603	2
RC0603FR-0749K9L	YAGEO	RES, 49.9kR, ±1%, 99mW	R101	R0603	1
RC0603FR-0751KL	YAGEO	RES, 51kR, ±1%, 100mW	R102	R0603	1
RC0603FR-07392KL	YAGEO	RES, 392kR, ±1%, 100mW	R103	R0603	1
RC0603FR-071KL	YAGEO	RES, 1kR, ±1%, 100mW	R104	R0603	1
RT0603BRD07448KL	YAGEO	RES, 448kR, ±1%, 100mW	R105	R0603	1
RT0603BRC07500RL	YAGEO	RES, 500R, ±1%, 100mW	R106	R0603	1
RC0603FR-070RL	YAGEO	RES, 0R, ±1%, 100mW	R107, R124, R125, R126, R127, R128, R129	R0603	7
RT0603BRD07226KL	YAGEO	RES, 226kR, ±1%, 100mW	R108	R0603	1
RC0603FR-071M	YAGEO	RES, 1MR, ±1%, 100mW	R109	R0603	1
RC0603FR-07100KL	YAGEO	RES, 100kR, ±1%, 100mW	R111	R0603	1
RC0603FR-0710KL	YAGEO	RES, 10kR, ±1%, 100mW	R112, R113, R114, R115, R118, R119, R120	R0603	7
RC0603FR-0710RL	YAGEO	RES, 10R, ±1%, 100mW	R116, R117	R0603	2
HojLR2512-3W-1mR	Milliohm	RES, 1mR, ±1%, 3W	R121, R122, R123, Rbus1, Rbus2, Rbus3	R2512	6
RC0603FR-0720RL	YAGEO	RES, 20R, ±1%, 100mW	R130, R131, R132	R0603	3
NCD0603B1		LED	D101, D102	led0603	2
FNR60455121MT	cjiang	Inductor, 120uH, ±20%, 940mA	L101	NR6045	1
LM5163QDDARQ1	TI	Buck	U101	ESOP_8	1
TLV1117-33IDCYR	TI	LDO	U102,	SOT_223	1
TLV1117-50IDCYR	TI	LDO	U112	SOT_223	1

REF3333AIDBZR	TI	Voltage Reference	U103	SOT_23_3	1
TXU0304RUTR	TI	Buffer	U104, U108	UQFN_12	2
INA290A1	TI	Current Sense Amplifier	U105	SC-70-5_L2.1	1
SN74LVC1G14	TI	Schmitt-Trigger Inverter	U106	SOT_23_5	1
LMV7235	TI	comparator	U107	SC_70_5	1
INA240A1DR	TI	Current Sense Amplifier	U109, U110, U111	SOIC_8	3
Header 2*6	Header		J101, J103, J104	Header 2*6	3
Header 2*4	Header		J102, J105, J106	Header 2_4	3
Header 2*5	Header		Motor Port	HDR2X10	1
Terminal			PGND, U, Udc, V, W	Terminal	5
NC			C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110	C1210	10
NC			C143, C144, C145	C0603	3
NC			R110	R0603	1
Daughterboard					
CC0603KRX7R0BB104	YAGEO	CAP,100n/100V, ±10%, X7R	C301, C306, C315, C316, C336, C337, C308, C309, C310, C311, C317, C318, C319, C320, C325, C326, C327, C328	C0603	18
CC0603JRNPO8BN101	YAGEO	CAP,100p/25V, ±5%, NP0	C302, C303, C307, C314, C323, C324, C331, C332, C338, C339, C340, C341	C0603	12
CC0603KRX7R8BB104	YAGEO	CAP,100n/25V, ±10%, X7R	C304, C333, C342	C0603	3
CC0603KRX7R8BB222	YAGEO	CAP, 2.2n/25V, ±10%, X7R	C305, C335, C343	C0603	3
CC0603KRX7R8BB104	YAGEO	CAP,100n/25V, ±10%, X7R	C334	C0603	1
0603WAF200JT5E	YAGEO	RES, 20R, ±1%, 100mW	R301, R306, R311, R317, R321, R327	R0603	6
0603WAF100JT5E	YAGEO	RES, 10R, ±1%, 100mW	R302, R308, R312, R319, R322, R329	R0603	6
RT0603BRD0720KL	YAGEO	RES, 20kR, ±1%, 100mW	R303, R307, R314, R318, R324, R328	R0603	6
RC0603FR-07100RL	YAGEO	RES, 100R, ±1%, 100mW	R304, R305, R315, R316, R325, R326	R0603	6
RT0603BRD077K5L	YAGEO	RES, 7.5kR, ±1%, 100mW	R309, R310, R313, R320, R323, R330	R0603	6
Header 2*6			J301, J303, J304	Header 2*6	3
Header 2*4			J302, J305, J306	Header 2_4	3
TP			TP301, TP303, TP304, TP305, TP306, TP309, TP310, TP312, TP315, TP316, TP317, TP318, TP320, TP323, TP324	TP	15
INN100EA035A	Innoscence	GaN	Q301, Q302, Q303, Q304,	En-FCLGA	6

			Q305, Q306		
INS2003FQ	Innoscience	driver	U301, U302, U303	INS2001	3
NC			C312, C313, C321, C322, C329, C330	C0603	6

历史版本

日期	版本	描述	编写
2025/05/09	1.0	第一版	AE 团队



Note:

There may be a dangerous voltage on the demo board, and exposure to high voltage may lead to safety problems such as injury or death.

Proper operating and safety procedures must be adhered to and used only for laboratory evaluation demonstrations and not directly to end-user equipment.



Reminder:

This product contains parts that are susceptible to electrostatic discharge (ESD). When using this product, be sure to follow antistatic procedures.



Disclaimer:

Innoscence reserves the right to make changes to the products or specifications described in this document at any time. All information in this document, including descriptions of product features and performance, is subject to change without notice. INNOIC ACCEPTSURBIT ACCEPTS NO LIABILITY ARISING OUT OF THE USE OF ANY EQUIPMENT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN. The performance specifications and operating parameters of the products described in this article are determined in a stand-alone state and are not guaranteed to be performed in the same manner when installed in the customer's product. Samples are not suitable for extreme environmental conditions. We make no representations or warranties, express or implied, as to the accuracy or completeness of the statements, technical information and advice contained herein and expressly disclaim any liability for any direct or indirect loss or damage suffered by any person as a result thereof. This document serves as a guide only and does not convey any license under the intellectual property rights of Innoscence or any third party.